

## СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ

### 9-е заседание Председатель – Терехов А.С.

- 9<sup>00</sup> – 9<sup>30</sup> **В.А.Гайслер**, И.А.Деребезов, А.В.Гайслер, Д.В.Дмитриев, А.И.Торопов  
Сверхминиатюрные излучатели на основе полупроводниковых наноструктур (**приглашенный доклад**)  
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск
- 9<sup>30</sup> – 9<sup>45</sup> **В.А.Ткаченко**, О.А.Ткаченко, А.С.Ярошевич, З.Д.Квон, Е.Е.Родякина, А.В.Латышев.  
СВЧ-фотокондактанс квантового точечного контакта.  
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск.
- 9<sup>45</sup>–10<sup>00</sup> **О.И.Семенова**  
Гибридные перовскиты – прорыв в солнечной энергетике.  
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова, Новосибирск.
- 10<sup>00</sup> – 10<sup>15</sup> **К.В.Феклистов**<sup>1</sup>, А.Г.Лемзяков<sup>3</sup>, А.А.Шкляев<sup>1,2</sup>, Г.К.Кривякин<sup>1,2</sup>, А.И.Комонов<sup>1</sup>, И.П.Просвиринов<sup>4</sup>, Д.В.Гуляев<sup>1</sup>, Д.С.Абрамкин<sup>1</sup>, Е.В.Спесивцев<sup>1</sup>, А.М.Пугачев<sup>5</sup>.  
Барьеры для инъекции носителей в ВЧ-магнетронно напыленные пленки In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:Er на кремнии.  
<sup>1</sup> Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;  
<sup>2</sup> Новосибирский государственный университет, Новосибирск;  
<sup>3</sup> Институт ядерной физики СО РАН, 630090, Новосибирск;  
<sup>4</sup> ИК СО РАН, Новосибирск;  
<sup>5</sup> ИАИЭ СО РАН, Новосибирск.
- 10<sup>15</sup> – 10<sup>30</sup> К.А.Свит<sup>1</sup>, **А.А.Зарубанов**<sup>1</sup>, Т.А.Дуда<sup>1</sup>, С.В.Трубина<sup>2</sup>, В.В.Зверева<sup>2</sup>, Е.В.Федосенко<sup>2</sup>, К.С.Журавлев<sup>1,3</sup>.  
Кристаллическая структура и преобладающие дефекты в квантовых точках CdS сформированные методом Ленгмюра-Блоджетт.  
<sup>1</sup> Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова, Новосибирск;  
<sup>2</sup> Институт неорганической химии им. А.В. Николаева, Новосибирск;  
<sup>3</sup> Новосибирский государственный университет, Новосибирск.
- 10<sup>30</sup> – 10<sup>45</sup> **А.В.Царев**<sup>1,2</sup>  
Новый тип оптического сенсора в структуре кремний на изоляторе.  
<sup>1</sup> Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;  
<sup>2</sup> Новосибирский государственный университет, Новосибирск.

10<sup>45</sup> – 11<sup>00</sup> **К.А.Лозовой**, В.В.Дирко, А.П.Коханенко, А.В.Войцеховский.  
Моделирование особенностей эпитаксиального формирования 2D- и 3D-островков с учетом изменения физических параметров двумерных пленок с толщиной с учетом изменения физических параметров двумерных пленок с толщиной.  
Томский государственный университет, Томск

11<sup>00</sup> – 11<sup>20</sup> Кофе-брейк

**10-е заседание Председатель – Климов А.Э.**

11<sup>20</sup> – 11<sup>35</sup> **Б.Г.Вайнер**<sup>1,2</sup>.  
Применение современной ИК термографии для изучения скорости пульсовой волны.

<sup>1</sup> Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;

<sup>2</sup> Новосибирский государственный университет, Новосибирск.

11<sup>35</sup> – 11<sup>50</sup> И.Ю.Гензе<sup>1</sup>, **М.С.Аксенов**<sup>2</sup>, Н.А.Валишева<sup>2</sup>, Д.В.Дмитриев<sup>2</sup>.

Влияние состава слоёв металлизации и отжига в формовочном газе на параметры барьеров Шоттки на основе In<sub>0.52</sub>Al<sub>0.48</sub>As.

<sup>1</sup> Новосибирский государственный университет, Новосибирск;

<sup>2</sup> Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск.

11<sup>50</sup> – 12<sup>05</sup> **В.В.Герасимов**<sup>1,2</sup>, А.К.Никитин<sup>2,3</sup>, О.В.Хитров<sup>3</sup>, А.Г.Лемзяков<sup>1,2</sup>.

Измерение оптических свойств металл-диэлектрических поверхностей с помощью терагерцовой поверхностно-плазмонной интерферометрии.

<sup>1</sup> Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН, Новосибирск;

<sup>2</sup> Новосибирский государственный университет, Новосибирск;

<sup>3</sup> Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН, Москва.

12<sup>05</sup> – 12<sup>20</sup> **Н.Н.Курूसь**<sup>1</sup>, И.А.Милёхин<sup>2</sup>, Н.А.Небогатикова<sup>1</sup>, И.В.Антонова<sup>1,3</sup>, Е.Е. Родякина<sup>1,3</sup>, А.Г.Милёхин<sup>1</sup>, А.В.Латышев<sup>1,3</sup>.

Исследование комбинационного рассеяния света графеном с нанометровым пространственным разрешением.

<sup>1</sup> Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;

<sup>2</sup> Semiconductor Physics, Chemnitz University of Technology, D-09107 Chemnitz, Germany.

12<sup>20</sup> – 12<sup>35</sup> **В.Г.Мансуров**, Ю.Г.Галицын, Т.В.Малин, Д.С.Милахин, А.С.Петров, К.С.Журавлев.

Процессы формирования упорядоченных двумерных фаз кремния (пористого силицена) на поверхности g-Si<sub>3</sub>N<sub>3</sub>/Si(111).

Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова, Новосибирск.

12<sup>35</sup> – 12<sup>50</sup>

**А.М.Можаров**<sup>1</sup>, К.Ю.Шугуров<sup>1</sup>, Г.А.Сапунов<sup>1</sup>, В.В.Федоров<sup>1</sup>,  
И.С.Мухин<sup>1,2</sup>.

Исследование работы диода Ганна в рамках новой многодолинной модели зоны проводимости.

<sup>1</sup> СПбАУ РАН, Академический университет, Санкт-Петербург;

<sup>2</sup> Университет ИТМО, Санкт-Петербург.

12<sup>50</sup> – 13<sup>05</sup>

**В.Н.Трухин**<sup>1</sup>, И.А.Мустафин<sup>1</sup>, F.V.Kusmartsev<sup>2,3</sup>, A.Kusmartseva<sup>2</sup>,  
Y.Liu<sup>3</sup>, B.Zhang<sup>3</sup>, Y.Luo<sup>3</sup>.

Генерация терагерцового излучения токами фотонного увлечения в квантовых ямах  $\alpha$ -Sn/Ge.(on-line)

<sup>1</sup> ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург;

<sup>2</sup> Department of Physics, Loughborough University, UK;

<sup>3</sup> Nano-fabrication laboratory, MTRC, China.

13<sup>05</sup> – 14<sup>00</sup>

Обед

15<sup>00</sup> – 18<sup>00</sup>

**Экскурсии**

